連結:http://pan.baidu.com/s/1dFxovKl

密碼:a79f

# 产品参数

[名称]: ADL5350混频器模块

[尺寸]: 46mm X 42mm

[供电电压范围]: DC 5V

[重量]: 13.7g

## 产品特点 | Highlights

ADL5350是一款高线性度、上/下变频混频器,能够在较宽的输入频率范围内工作,非常适合要求高灵敏度和高效抗扰度的蜂窝基站混频器设计。这款器件基于GaAspHEMT、单端混频器架构,能提供出色的输入线性度和低噪声系数,而无需高功耗



本机振荡器(LO)驱动。

#### 主要参数

供电: DC5V

频段: LF-4GHz

噪声系数: 6.5dB

输入IP3: 25dBm

输入P1dB: 19dBm

RF Input level: 23dBm

LO Input level: 20dBm



ADL5350是一款高线性度、上/下变频混频器,能够在较宽的输入频率范围内工作,非常适合要求高灵敏度和高效抗扰度的蜂窝基站混频器设计。这款器件基于GaAs pHEMT、单端混频器架构,能提供出色的输入线性度和低噪声系数,而无需高功耗本机振荡器(LO)驱动。

在850 MHz/900 MHz接收应用中,ADL5350的典型变频损耗仅为6.8 dB。集成的L0放大器只需一个低L0驱动电平,对于大多数应用,其典型值仅为4 dBm。输入IP3典型值大于25 dBm,输入压缩点为19 dBm。该器件具有高输入线性度,因而是适合GSM 850/900和800 MHz CDMA2000等要求高抗扰度通信系统的出色混频器。在2 GHz时,需要一个略微较高的电源电流才能获得类似的件能。

借助单端宽带RF/IF端口,该器件能够利用简单的外部滤波器网络,针对所需工作频带进行定制。LO至RF隔离基于RF端口滤波器网络的LO抑制。采用更高阶滤波器网络可以实现更大的隔离,详情参见本数据手册的应用信息部分。

ADL5350采用GaAs pHEMT、高性能IC工艺制造,提供3 mm x 2 mm、8引脚LFCSP封装,工作温度范围为 40°C至+85°C

## 芯片特点

宽带射频(RF)、中频(IF)和本机振荡器(LO)端口

变频损耗: 6.8 dB

噪声系数: 6.5 dB

高输入IP3: 25 dBm

高输入P1dB: 19 dBm

低LO驱动电平

单端设计: 无需平衡-非平衡变换器

单电源供电: 3 V (19 mA)

2 mm × 3 mm、8引脚小型LFCSP封装

符合RoHS标准

## 芯片应用

蜂窝基站/点对点无线电链路/RF仪器仪表

